

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT
D'UN CHANGEMENT

(règle 92bis.1 et
instruction administrative 422 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

BREVATOME
3, rue du Docteur-Lancereaux
F-75008 Paris
FRANCE

Date d'expédition (jour/mois/année) 08 février 2000 (08.02.00)	NOTIFICATION IMPORTANTE
Référence du dossier du déposant ou du mandataire B 12923.3 PA	
Demande internationale no PCT/FR98/02848	Date du dépôt international (jour/mois/année) 23 décembre 1998 (23.12.98)

1. Les renseignements suivants étaient enregistrés en ce qui concerne:

☐ le déposant ☐ l'inventeur ☒ le mandataire ☐ le représentant commun

Nom et adresse

BREVATOME
25, rue de Ponthieu
F-75008 Paris
FRANCE

Nationalité (nom de l'Etat)

Domicile (nom de l'Etat)

no de téléphone

01 53 83 94 00

no de télécopieur

01 45 63 83 33

no de téléimprimeur

2. Le Bureau international notifie au déposant que le changement indiqué ci-après a été enregistré en ce qui concerne:

☐ la personne ☐ le nom ☒ l'adresse ☐ la nationalité ☐ le domicile

Nom et adresse

BREVATOME
3, rue du Docteur-Lancereaux
F-75008 Paris
FRANCE

Nationalité (nom de l'Etat)

Domicile (nom de l'Etat)

no de téléphone

01 53 83 94 00

no de télécopieur

01 45 63 83 33

no de téléimprimeur

3. Observations complémentaires, le cas échéant:

4. Une copie de cette notification a été envoyée:

☒ à l'office récepteur ☐ aux offices désignés concernés
☐ à l'administration chargée de la recherche internationale ☒ aux offices élus concernés
☐ à l'administration chargée de l'examen préliminaire international ☐ autre destinataire:

Bureau international de l'OMPI
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20, Suisse

no de télécopieur (41-22) 740.14.35

Fonctionnaire autorisé:

Eugénia Santos

no de téléphone (41-22) 338.83.38

THIS PAGE BLANK (USPTO)



TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

United States Patent and Trademark
Office
(Box PCT)
Crystal Plaza 2
Washington, DC 20231
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

en sa qualité d'office élu

Date d'expédition (jour/mois/année) 22 juillet 1999 (22.07.99)	Demande internationale no PCT/FR98/02848	Référence du dossier du déposant ou du mandataire B 12923.3 PA
Date du dépôt international (jour/mois/année) 23 décembre 1998 (23.12.98)	Date de priorité (jour/mois/année) 24 décembre 1997 (24.12.97)	
Déposant FERRAND, Bernard etc		

1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:



dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:

19 juin 1999 (19.06.99)



dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:

2. L'élection



a été faite



n'a pas été faite

avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20, Suisse

no de télécopieur: (41-22) 740.14.35

Fonctionnaire autorisé

R. Forax

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT

REQUETE

Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

Réservé à l'office récepteur

Demande internationale n°

Date du dépôt international

Nom de l'office récepteur et "Demande internationale PCT"

Référence du dossier du déposant ou du mandataire (facultatif)
(12 caractères au maximum) B 12923.3 PA

Cadre n° I TITRE DE L'INVENTION
CAVITE LASER A DECLENCHEMENT PASSIF A POLARISATION CONTROLEE, MICROLASER COM-
PRENANT CETTE CAVITE, ET PROCEDE DE FABRICATION DE CE MICROLASER

Cadre n° II DEPOSANT

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
31-33, rue de la Fédération
75015 PARIS
FRANCE

☐ Cette personne est aussi inventeur.

n° de téléphone
01 69 08 82 93

n° de télécopieur
01 69 08 82 92

n° de téléimprimeur

Nationalité (nom de l'Etat) : FR

Domicile (nom de l'Etat) : FR

Cette personne est déposant pour : ☐ tous les Etats désignés ☒ tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique ☐ les Etats-Unis d'Amérique seulement ☐ les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire

Cadre n° III AUTRE(S) DEPOSANT(S) OU (AUTRE(S)) INVENTEUR(S)

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

FERRAND Bernard
115, rue du Plassarot
38340 VOREPPE
FRANCE

Cette personne est :

☐ déposant seulement

☒ déposant et inventeur

☐ inventeur seulement
(Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)

Nationalité (nom de l'Etat) : FR

Domicile (nom de l'Etat) : FR

Cette personne est déposant pour : ☐ tous les Etats désignés ☐ tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique ☒ les Etats-Unis d'Amérique seulement ☐ les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire

☒ D'autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une feuille annexe.

Cadre n° IV MANDATAIRE OU REPRESENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE

La personne dont l'identité est donnée ci-dessous est/ a été désignée pour agir au nom du ou des déposants auprès des autorités internationales compétentes, comme: ☒ mandataire ☐ représentant commun

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)

BREVATOME
25, rue de Ponthieu
75008 PARIS
FRANCE

n° de téléphone
01 53 83 94 00

n° de télécopieur
01 45 63 83 33

n° de téléimprimeur

☐ Adresse pour la correspondance : cocher cette case lorsque aucun mandataire ni représentant commun n'est/n'a été désigné et que l'espace ci-dessus est utilisé pour indiquer une adresse spéciale à laquelle la correspondance doit être envoyée.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Suite du cadre n° III AUTRE(S) DEPOSANT(S) OU (AUTRE(S)) INVENTEUR(S)			
<i>Si aucun des sous-cadres suivants n'est utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.</i>			
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom: pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.) CHAMBAZ Bernard 60, rue de la Liberté 38180 SEYSSINS FRANCE		Cette personne est : <input type="checkbox"/> déposant seulement <input checked="" type="checkbox"/> déposant et inventeur <input type="checkbox"/> inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)	
Nationalité (nom de l'Etat) : FR		Domicile (nom de l'Etat) : FR	
Cette personne est déposant pour : <input type="checkbox"/> tous les Etats désignés <input type="checkbox"/> tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique <input checked="" type="checkbox"/> les Etats-Unis d'Amérique seulement <input type="checkbox"/> les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire			
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom: pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.) FULBERT Laurent 56, avenue d'Haussez 38500 VOIRON FRANCE		Cette personne est : <input type="checkbox"/> déposant seulement <input checked="" type="checkbox"/> déposant et inventeur <input type="checkbox"/> inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)	
Nationalité (nom de l'Etat) : FR		Domicile (nom de l'Etat) : FR	
Cette personne est déposant pour : <input type="checkbox"/> tous les Etats désignés <input type="checkbox"/> tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique <input checked="" type="checkbox"/> les Etats-Unis d'Amérique seulement <input type="checkbox"/> les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire			
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom: pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.) MARTY Jean 3, rue des Alouettes 38180 SEYSSINS FRANCE		Cette personne est : <input type="checkbox"/> déposant seulement <input checked="" type="checkbox"/> déposant et inventeur <input type="checkbox"/> inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)	
Nationalité (nom de l'Etat) : FR		Domicile (nom de l'Etat) : FR	
Cette personne est déposant pour : <input type="checkbox"/> tous les Etats désignés <input type="checkbox"/> tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique <input checked="" type="checkbox"/> les Etats-Unis d'Amérique seulement <input type="checkbox"/> les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire			
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom: pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.) 		Cette personne est : <input type="checkbox"/> déposant seulement <input type="checkbox"/> déposant et inventeur <input type="checkbox"/> inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)	
Nationalité (nom de l'Etat) :		Domicile (nom de l'Etat) :	
Cette personne est déposant pour : <input type="checkbox"/> tous les Etats désignés <input type="checkbox"/> tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique <input type="checkbox"/> les Etats-Unis d'Amérique seulement <input type="checkbox"/> les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire			
<input type="checkbox"/> D'autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une autre feuille annexe.			

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Cadre n° V DESIGNATION D'ETATS

Les désignations suivantes sont faites conformément à la règle 4.9.a) (cocher les cases appropriées; une au moins doit l'être) :

Brevet régional

- ☐ AP Brevet ARIPO : GH Ghana, GM Gambie, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Soudan, SZ Swaziland, UG Ouganda, ZW Zimbabwe et tout autre Etat qui est un Etat contractant du Protocole de Harare et du PCT
- ☐ EA Brevet eurasien : AM Arménie, AZ Azerbaïdjan, BY Bélarus, KG Kirghizistan, KZ Kazakhstan, MD République de Moldova, RU Fédération de Russie, TJ Tadjikistan, TM Turkménistan et tout autre Etat qui est un Etat contractant de la Convention sur le brevet eurasien et du PCT
- ☒ EP Brevet européen : AT Autriche, BE Belgique, CH et LI Suisse et Liechtenstein, CY Chypre, DE Allemagne, DK Danemark, ES Espagne, FI Finlande, FR France, GB Royaume-Uni, GR Grèce, IE Irlande, IT Italie, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Pays-Bas, PT Portugal, SE Suède et tout autre Etat qui est un Etat contractant de la Convention sur le brevet européen et du PCT
- ☐ OA Brevet OAPI : BF Burkina Faso, BJ Bénin, CF République centrafricaine, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroun, GA Gabon, GN Guinée, GW Guinée-Bissau, ML Mali, MR Mauritanie, NE Niger, SN Sénégal, TD Tchad, TG Togo et tout autre Etat qui est un Etat membre de l'OAPI et un état contractant du PCT (si une autre forme de protection ou de traitement est souhaitée, le préciser sur la ligne pointillée)

Brevet national (si une autre forme de protection ou de traitement est souhaitée, le préciser sur la ligne pointillée) :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> AL Albanie | <input type="checkbox"/> LS Lesotho |
| <input type="checkbox"/> AM Arménie | <input type="checkbox"/> LT Lituanie |
| <input type="checkbox"/> AT Autriche | <input type="checkbox"/> LU Luxembourg |
| <input type="checkbox"/> AU Australie | <input type="checkbox"/> LV Lettonie |
| <input type="checkbox"/> AZ Azerbaïdjan | <input type="checkbox"/> MD République de Moldova |
| <input type="checkbox"/> BA Bosnie-Herzégovine | <input type="checkbox"/> MG Madagascar |
| <input type="checkbox"/> BB Barbade | <input type="checkbox"/> MK Ex-République yougoslave de Macédoine |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgarie | <input type="checkbox"/> MN Mongolie |
| <input type="checkbox"/> BR Brésil | <input type="checkbox"/> MW Malawi |
| <input type="checkbox"/> BY Bélarus | <input type="checkbox"/> MX Mexique |
| <input type="checkbox"/> CA Canada | <input type="checkbox"/> NO Norvège |
| <input type="checkbox"/> CH et LI Suisse et Liechtenstein | <input type="checkbox"/> NZ Nouvelle-Zélande |
| <input type="checkbox"/> CN Chine | <input type="checkbox"/> PL Pologne |
| <input type="checkbox"/> CU Cuba | <input type="checkbox"/> PT Portugal |
| <input type="checkbox"/> CZ République tchèque | <input type="checkbox"/> RO Roumanie |
| <input type="checkbox"/> DE Allemagne | <input type="checkbox"/> RU Fédération de Russie |
| <input type="checkbox"/> DK Danemark | <input type="checkbox"/> SD Soudan |
| <input type="checkbox"/> EE Estonie | <input type="checkbox"/> SE Suède |
| <input type="checkbox"/> ES Espagne | <input type="checkbox"/> SG Singapour |
| <input type="checkbox"/> FI Finlande | <input type="checkbox"/> SI Slovénie |
| <input type="checkbox"/> GB Royaume-Uni | <input type="checkbox"/> SK Slovaquie |
| <input type="checkbox"/> GE Géorgie | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone |
| <input type="checkbox"/> GH Ghana | <input type="checkbox"/> TJ Tadjikistan |
| <input type="checkbox"/> GM Gambie | <input type="checkbox"/> TM Turkménistan |
| <input type="checkbox"/> HR Croatie | <input type="checkbox"/> TR Turquie |
| <input type="checkbox"/> HU Hongrie | <input type="checkbox"/> TT Trinité-et-Tobago |
| <input type="checkbox"/> ID Indonésie | <input type="checkbox"/> UA Ukraine |
| <input type="checkbox"/> IL Israël | <input type="checkbox"/> UG Ouganda |
| <input type="checkbox"/> IS Islande | <input checked="" type="checkbox"/> US Etats-Unis d'Amérique |
| <input checked="" type="checkbox"/> JP Japon | <input type="checkbox"/> UZ Ouzbékistan |
| <input type="checkbox"/> KE Kenya | <input type="checkbox"/> VN Viet Nam |
| <input type="checkbox"/> KG Kirghizistan | <input type="checkbox"/> YU Yougoslavie |
| <input type="checkbox"/> KP République populaire démocratique de Corée | <input type="checkbox"/> ZW Zimbabwe |
| <input type="checkbox"/> KR République de Corée | |
| <input type="checkbox"/> KZ Kazakhstan | |
| <input type="checkbox"/> LC Sainte-Lucie | |
| <input type="checkbox"/> LK Sri Lanka | |
| <input type="checkbox"/> LR Libéria | |

Cases réservées pour la désignation (aux fins d'un brevet national) d'Etats qui sont devenus parties au PCT après la publication de la présente feuille :

- ☐
- ☐

Déclaration concernant les désignations de précaution : outre les désignations faites ci-dessus, le déposant fait aussi conformément à la règle 4.9.b) toutes les désignations qui seraient autorisées en vertu du PCT, à l'exception de toute désignation indiquée dans le cadre supplémentaire comme étant exclue de la portée de cette déclaration. Le déposant déclare que ces désignations additionnelles sont faites sous réserve de confirmation et que toute désignation qui n'est pas confirmée avant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de priorité doit être considérée comme retirée par le déposant à l'expiration de ce délai. (Pour confirmer une désignation, il faut déposer une déclaration contenant la désignation en question et payer les taxes de désignation et de confirmation. La confirmation doit parvenir à l'office récepteur dans le délai de 15 mois.)

THIS PAGE BLANK (USPTO)


Cadre n° VI REVENDEICATION DE PRIORITE		<input type="checkbox"/> D'autres revendications de priorité sont indiquées dans le cadre supplémentaire.		
Date de dépôt de la demande antérieure (jour/mois/année)	Numéro de la demande antérieure	Lorsque la demande antérieure est une :		
		demande nationale : pays	demande régionale : * office régional	demande internationale : office récepteur
(1) (24.12.97) 24 décembre 1997	97 16518	FRANCE		
(2)				
(3)				

☐ L'office récepteur est prié de préparer et de transmettre au Bureau international une copie certifiée conforme de la ou des demandes antérieures (seulement si la demande antérieure a été déposée auprès de l'office qui, aux fins de la présente demande internationale, est l'office récepteur) indiquées ci-dessus au(x) point(s) : _____

* Si la demande antérieure est une demande ARIPO, il est obligatoire d'indiquer dans le cadre supplémentaire au moins un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lequel cette demande antérieure a été déposée (règle 4.10.b)ii). Voir le cadre supplémentaire.

Cadre n° VII ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE			
Choix de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) (si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche internationale, indiquer l'administration choisie; le code à deux lettres peut être utilisé) : ISA /	Demande d'utilisation des résultats d'une recherche antérieure; mention de cette recherche (si une recherche antérieure a été effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale ou demandée à cette dernière) : Date (jour/mois/année) Numéro Pays (ou office régional) 18 septembre 1998 FA 552205 FRANCE		

Cadre n° VIII BORDEREAU; LANGUE DE DEPOT	
La présente demande internationale contient le nombre de feuilles suivant : requête : 4 description (sauf partie réservée au listage des séquences) : 26 revendications : 3 abrégé : 1 dessins : 0 partie de la description réservée au listage des séquences : _____ Nombre total de feuilles : 34	Le ou les éléments cochés ci-après sont joints à la présente demande internationale : 1. <input type="checkbox"/> feuille de calcul des taxes 2. <input type="checkbox"/> pouvoir distinct signé 3. <input checked="" type="checkbox"/> copie du pouvoir général; numéro de référence, le cas échéant : 07085 4. <input type="checkbox"/> explication de l'absence d'une signature 5. <input checked="" type="checkbox"/> document(s) de priorité indiqué(s) dans le cadre n° VI au(x) point(s) : 1 6. <input type="checkbox"/> traduction de la demande internationale en (langue) : 7. <input type="checkbox"/> indications séparées concernant des micro-organismes ou autre matériel biologique déposés 8. <input type="checkbox"/> listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sous forme déchiffrable par ordinateur 9. <input checked="" type="checkbox"/> autres éléments (préciser) : Rapport de Recherche
Figure des dessins qui doit accompagner l'abrégé : /	Langue de dépôt de la demande internationale : Français

Cadre n° IX SIGNATURE DU DEPOSANT OU DU MANDATAIRE	
A côté de chaque signature, indiquer le nom du signataire et, si cela n'apparaît pas clairement à la lecture de la requête, à quel titre l'intéressé signe.	
 P. AUDIER	

Réservé à l'office récepteur	
1. Date effective de réception des pièces supposées constituer la demande internationale : 3. Date effective de réception, rectifiée en raison de la réception ultérieure, mais dans les délais, de documents ou de dessins complétant ce qui est supposé constituer la demande internationale : 4. Date de réception, dans les délais, des corrections demandées selon l'article 11.2) du PCT :	2. Dessins : <input type="checkbox"/> reçus : <input type="checkbox"/> non reçus :
5. Administration chargée de la recherche internationale (si plusieurs sont compétentes) : ISA /	6. <input type="checkbox"/> Transmission de la copie de recherche différée jusqu'au paiement de la taxe de recherche.

Réservé au Bureau international	
Date de réception de l'exemplaire original par le Bureau international :	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

09/582256
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

2881

Applicant's or agent's file reference B 12923.3 PA	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/FR98/02848	International filing date (day/month/year) 23 December 1998 (23.12.98)	Priority date (day/month/year) 24 December 1997 (24.12.97)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01S 3/06		
Applicant COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

RECEIVED
FEB 23 1999
TC 200 MAIL ROOM

Date of submission of the demand 19 June 1999 (19.06.99)	Date of completion of this report 06 October 1999 (06.10.1999)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR98/02848

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-26, as originally filed,
 pages _____, filed with the demand,
 pages _____, filed with the letter of _____,
 pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. 1-16, as originally filed,
 Nos. _____, as amended under Article 19,
 Nos. _____, filed with the demand,
 Nos. _____, filed with the letter of _____,
 Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☐ the drawings, sheets/fig _____, as originally filed,
 sheets/fig _____, filed with the demand,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

THIS PAGE BLANK (USPTO)

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-16	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-16	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-16	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. Claims 1, 15:

The present invention concerns a laser cavity including a substrate of an optionally doped active laser material $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG), on which a monocrystalline layer of a saturable absorbent doped YAG material is deposited.

The closest prior art is represented by document US-A-5 394 413 (ISR: Y document) or EP-A-0 653 824 (ISR: Y document).

The purpose is to obtain a laser cavity emitting a beam of constant polarisation, whatever the nature of the pumping source.

The invention differs therefrom in terms of the following inventive features of Claim 1:

Said active laser material is oriented [100], and said monocrystalline saturable absorbent material is deposited according to the same orientation [100].

Document IEEE Journal of Selected Topics in Quantum

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Electronics, vol. 3, no. 1, February 1997, pages 26-28 (ISR: Y document) describes a laser cavity including a single $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ (YAG) crystal, one part of which is formed of the active, Nd-doped material, and another part of which is formed of the saturable absorbent, Cr-doped material. This laser cavity therefore differs from that of Claim 1.

Consequently, the subject matter of Claim 1 is not obvious.

For the reasons mentioned above, the production method claimed in Claim 15 is not obvious either.

2. Claims 2-14, 16:

These claims are dependent on Claims 1 and 15; the subject matter thereof is therefore also novel and inventive.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR 98/02848

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The feature of Claim 1, "... by liquid-phase epitaxy or a similar method..." relates to a method step in a device claim. The subject matter of Claim 1 is therefore unclear (PCT Article 6).

THIS PAGE BLANK (USPTO)

TRAITÉ DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS

Expéditeur: L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE
L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Destinataire:

BREVATOME
25, rue de Ponthieu
F-75008 Paris
FRANCE

BREVATOME

11 OCT. 1999

3, rue du Docteur Lancereaux
75008 PARIS

PCT

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU
RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE
INTERNATIONAL
(règle 71.1 du PCT)

Date d'expédition **06. 10. 99**
(jour/mois/année)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire
B 12923.3 PA

NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande internationale No.
PCT/FR98/02848

Date du dépôt international (jour/mois/année)
23/12/1998

Date de priorité (jour/mois/année)
24/12/1997

Déposant

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al.

1. Il est notifié au déposant que l'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi le rapport d'examen préliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagné, le cas échéant, de ces annexes.

2. Une copie du présent rapport et, le cas échéant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour communication à tous les offices élus.

3. Si tel ou tel office élu l'exige, le Bureau international établira une traduction en langue anglaise du rapport (à l'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices intéressés.

4. RAPPEL

Pour aborder la phase nationale auprès de chaque office élu, le déposant doit accomplir certains actes (dépôt de traduction et paiement des taxes nationales) dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoyé par le Bureau international dans le formulaire PCT/IB/301).

Lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, elle doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international. Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé.

Pour plus de précisions en ce qui concerne les délais applicables et les exigences des offices élus, voir I Volume II du Guide du déposant du PCT.

Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen
préliminaire international



Office européen des brevets
D-80298 Munich
Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire autorisé

Hauschild, W

Tél. +49 89 2399-2402




THIS PAGE BLANK (USPTO)

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire B 12923.3 PA	voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416) POUR SUITE A DONNER	
Demande internationale n° PCT/FR98/02848	Date du dépôt international (jour/mois/année) 23/12/1998	Date de priorité (jour/mois/année) 24/12/1997
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB H01S3/06		
Déposant COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al.		
<p>1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.</p> <p>2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.</p> <p><input type="checkbox"/> Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).</p> <p>Ces annexes comprennent feuilles.</p>		
<p>3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> I <input checked="" type="checkbox"/> Base du rapport II <input type="checkbox"/> Priorité III <input type="checkbox"/> Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle IV <input type="checkbox"/> Absence d'unité de l'invention V <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration VI <input type="checkbox"/> Certains documents cités VII <input type="checkbox"/> Irrégularités dans la demande internationale VIII <input checked="" type="checkbox"/> Observations relatives à la demande internationale 		
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 19/06/1999	Date d'achèvement du présent rapport 06. 10. 99	
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international:  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Pazionis, G N° de téléphone +49 89 2399 2558	



THIS PAGE BLANK (USPTO)

**RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR98/02848

I. Base du rapport

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (*les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications.*) :

Description, pages:

1-26 version initiale

Revendications, N°:

1-16 version initiale

2. Les modifications ont entraîné l'annulation :

- ☐ de la description, pages :
☐ des revendications, n°s :
☐ des dessins, feuilles :

3. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui : Revendications 1-16 Non : Revendications
Activité inventive	Oui : Revendications 1-16 Non : Revendications
Possibilité d'application industrielle	Oui : Revendications 1-16 Non : Revendications

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR98/02848

2. Citations et explications

voir feuille séparée

VIII. Observations relatives à la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

voir feuille séparée

THIS PAGE BLANK (USPTO)

V.2.

1. Revendications 1, 15:

La présente invention concerne une cavité laser comprenant un substrat en matériau actif laser $Y_3 Al_5 O_{12}$ (YAG) dopé ou non, sur lequel est déposée une couche monocristalline de matériau absorbant saturable en YAG dopé.

L'état de la technique le plus proche est représenté par US-A-5394413 (RDRI:Y doc.) ou EP-A-0653824 (RDRI:Y doc.).

Le but poursuivi est d'obtenir une cavité laser émettant un faisceau à polarisation constante quelle que soit la nature de la source de pompage.

L'invention s'en distingue par les caractéristiques inventives suivantes de la revendication 1:

Ledit matériau actif laser est orienté [100], et ladite couche monocristalline de matériau absorbant saturable est déposée suivant la même orientation [100].

Le document IEEE Journal of selected Topics in Quantum Electronics, vol. 3, no. 1, février 1997, pages 26-28 (RDRI:Y doc) décrit une cavité laser comprenant un seul cristal de $Y_3 Al_5 O_{12}$ (YAG), dont une partie est le matériau actif, dopée avec Nd et dont une autre partie est le matériau absorbant saturable, dopée avec Cr. Cette cavité laser est donc différente de la cavité laser de la revendication 1.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 n'est pas évident.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus le procédé de fabrication tel que revendiqué dans la revendication 15 aussi n'est pas évident.

2. Revendications 2-14,16:

Ces revendications sont dépendantes des revendications 1 et 15 et leur objet est

THIS PAGE BLANK (USPTO)

donc également nouveau et inventif.

VIII.

La caractéristique de la revendication 1 "...par épitaxie en phase liquide ou par un procédé analogue..." reflète une étape de procédé dans une revendication de dispositif. L'objet de la revendication 1 n'est donc pas clair (Art. 6 PCT).

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCTORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Bureau international

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : H01S 3/06	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 99/34486 (43) Date de publication internationale: 8 juillet 1999 (08.07.99)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR98/02848 (22) Date de dépôt international: 23 décembre 1998 (23.12.98) (30) Données relatives à la priorité: 97/16518 24 décembre 1997 (24.12.97) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): COMMIS-SARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75015 Paris (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): FERRAND, Bernard [FR/FR]; 115, rue du Plassarot, F-38340 Voreppe (FR). CHAMBAZ, Bernard [FR/FR]; 60, rue de la Liberté, F-38180 Seyssins (FR). FULBERT, Laurent [FR/FR]; 56, avenue d'Haussez, F-38500 Voiron (FR). MARTY, Jean [FR/FR]; 3, rue des Alouettes, F-38180 Seyssins (FR). (74) Mandataire: BREVATOME; 25, rue de Ponthieu, F-75008 Paris (FR).		(81) Etats désignés: JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>
(54) Title: PASSIVE Q-SWITCHED MICROLASER WITH CONTROLLED POLARISATION (54) Titre: MICROLASER A DECLenchement PASSIF ET A POLARISATION CONTROLEE (57) Abstract <p>The invention concerns a saturable absorbent passive Q-switched laser cavity with controlled polarisation, and a laser, in particular a microlaser comprising said cavity and means for pumping said cavity. The invention also concerns a method for making said microlaser. The laser cavity with controlled polarisation comprises a substrate made of an active Y₃Al₅O₁₂ (YAG) laser material doped or not, whereon is directly deposited by epitaxy in liquid phase or by any other similar process, a monocrystalline layer of YAG-doped saturable absorbent material, wherein said active laser material is oriented [100], and said monocrystalline layer of adsorbent saturable material is deposited along the same orientation [100].</p> (57) Abrégé <p>La présente invention a trait à une cavité laser à déclenchement passif par absorbant saturable et à polarisation contrôlée, et à un laser, en particulier un microlaser, comprenant ladite cavité et des moyens de pompage de cette cavité. L'invention concerne également un procédé de fabrication dudit microlaser. La cavité laser à polarisation contrôlée comprend un substrat en matériau actif laser Y₃Al₅O₁₂ (YAG) dopé ou non, sur lequel est déposé directement par épitaxie en phase liquide ou par un procédé analogue, une couche monocristalline de matériau absorbant saturable en YAG dopé, dans laquelle ledit matériau actif laser est orienté [100], et ladite couche monocristalline de matériau absorbant saturable est déposée suivant la même orientation [100].</p>		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Bésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroun	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

MICROLASER A DECLENCHEMENT PASSIF ET A POLARISATION CONTROLEE

DESCRIPTION

5 La présente invention a trait à une cavité laser à déclenchement passif par absorbant saturable et à polarisation contrôlée, et à un laser en particulier un microlaser comprenant ladite cavité et des moyens de pompage de cette cavité.

10 L'invention concerne également un procédé de fabrication dudit microlaser.

 Le domaine de l'invention peut de manière très générale être défini comme étant celui des lasers déclenchés et en particulier des microlasers déclenchés
15 pompés par diode qui se développent très intensément aujourd'hui.

 Un des avantages du microlaser réside dans sa structure en un empilement de multicouches. Le milieu actif laser est constitué par un matériau de
20 faible épaisseur par exemple, entre 150-1 000 μm et de petites dimensions (quelques mm^2), sur lequel des miroirs diélectriques de cavité sont directement déposés. Ce milieu actif peut être pompé par une diode laser III-V qui est soit directement hybridée sur le
25 microlaser, soit couplée à ce dernier par fibre optique. La possibilité d'une fabrication collective utilisant les moyens de la micro-électronique autorise une production de masse de ces microlasers à très faible coût.

30 Les microlasers ont de nombreuses applications, dans des domaines aussi variés que

l'industrie automobile, l'environnement,
l'instrumentation scientifique, la télémétrie, etc...

Les microlasers connus ont, en général, une
émission continue de quelques dizaines de mW de
5 puissance. Cependant, la plupart des applications
citées ci-dessus, nécessitent des puissances crêtes
(puissance instantanée) de quelques kW délivrées
pendant 10^{-8} à 10^{-9} secondes, avec une puissance moyenne
de quelques dizaines de mW.

10 Dans les lasers solides, on peut obtenir de
telles puissances crêtes élevées en les faisant
fonctionner en mode pulsé à des fréquences variant
entre 10 et 10^4 Hz. Pour cela, on utilise des procédés
bien connus de déclenchement, par exemple par
15 « Q-switch ».

De façon plus précise, déclencher une
cavité laser consiste à rajouter dans celle-ci des
pertes variables dans le temps qui vont empêcher
l'effet laser pendant un certain temps, durant lequel
20 l'énergie de pompage est stockée dans le niveau excité
du matériau à gain. Ces pertes sont brusquement
diminuées, à des moments précis, libérant ainsi
l'énergie emmagasinée en un temps très court (« giant
pulse » ou impulsion géante). On atteint ainsi une
25 puissance crête élevée.

Dans le cas d'un déclenchement dit actif,
la valeur des pertes est pilotée de façon externe par
l'utilisateur (exemple : miroir de cavité tournant,
acousto-optique ou électro-optique intracavité
30 changeant soit le trajet du faisceau, soit son état de
polarisation). La durée de stockage, l'instant
d'ouverture de la cavité, ainsi que le taux de
répétition peuvent être choisis indépendamment. En

contrepartie, cela nécessite une électronique adaptée et complique le système laser.

Un microlaser déclenché activement est décrit par exemple dans le document EP-A-724 316.

5 Dans le cas d'un déclenchement dit passif, les pertes variables sont introduites dans la cavité sous forme d'un matériau (appelé Absorbant Saturable - A. S. -) qui est fortement absorbant (transmission T_{min}) à la longueur d'onde laser, à
10 faible densité de puissance, et qui devient pratiquement transparent (transmission T_{max}) lorsque cette densité dépasse un certain seuil qu'on appelle intensité de saturation de l'A. S.

 L'énorme avantage du déclenchement passif
15 est qu'il ne nécessite aucune électronique de pilotage, et que donc les impulsions peuvent être générées sans intervention extérieure.

 Pour ce type de fonctionnement, dit « déclenchement passif », l'utilisateur peut choisir,
20 d'une part, la transmission minimum (T_{min}) de l'absorbant saturable, afin de l'adapter au pompage disponible et, d'autre part, la cavité laser, par l'intermédiaire de la géométrie et de la transmission du miroir de sortie.

25 Une fois ces paramètres fixés, le système a un point de fonctionnement caractérisé par la durée des impulsions (« pulses ») émises, la fréquence de répétition, et la puissance émise, ainsi que l'énergie par impulsion (« pulse »).

30 Les caractéristiques telles que l'énergie et la durée de l'impulsion laser dépendent de celles de l'absorbant saturable et de l'oscillateur.

Par contre, la fréquence de répétition des impulsions est directement proportionnelle à la puissance de la diode laser de pompe. Le faisceau laser obtenu présente des caractéristiques presque parfaites: généralement monomode transverse et longitudinal, faisceau gaussien limité par la diffraction.

Les monocristaux utilisés comme absorbant saturable (A. S.) doivent donc présenter des caractéristiques bien précises qui sont obtenues par un contrôle très précis des substitutions et de l'épaisseur du matériau.

Les microlasers, actuellement fabriqués, tels que les microlasers déclenchés passivement comprennent généralement un milieu ou matériau actif solide qui peut être constitué d'un matériau de base choisi, par exemple parmi $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG), $LaMgAl_{11}O_9$ (LMA), YVO_4 , Y_2SiO_5 , $YLiF_4$ et $GdVO_4$ dopés avec un élément tel que l'Erbium (Er), l'Ytterbium (Yb), le Néodyme (Nd), le Thulium (Tm), l'Holmium (Ho), ou codopés par un mélange de plusieurs de ces éléments, tels que Er et Yb, ou Tm et Ho.

Les microlasers fonctionnent à différentes longueurs d'ondes suivant leur substitution, ainsi leur longueur d'onde d'émission est autour de $1,06 \mu m$, lorsque la matière active est dopée par Nd^{3+} , autour de $1,55 \mu m$, lorsqu'elle est dopée par Er^{3+} , Yb^{3+} , et autour de $2 \mu m$, lorsqu'elle est dopée par Tm^{3+} et Ho^{3+} .

Par ailleurs, des absorbants saturables connus contiennent des molécules organiques responsables de l'absorption. Ces matériaux, qui se présentent sous forme liquide ou plastique, sont très souvent de mauvaise qualité optique, vieillissent très vite et ont une mauvaise tenue au flux laser.

Des matériaux solides massifs sont aussi utilisés en tant qu'absorbants saturables. Par exemple pour les lasers émettant autour de $1\text{ }\mu\text{m}$, dont la matière active est constituée de YAG avec des ions actifs Nd^{3+} ou Yb^{3+} , on peut utiliser des cristaux de $\text{LiF} : \text{F}_2$ comportant des centres colorés responsables du comportement d'absorbant saturable du matériau et qui ont une durée de vie limitée, ou bien encore certains cristaux massifs dopés au Cr^{4+} qui présentent une absorption saturable autour de $1\text{ }\mu\text{m}$.

Les absorbants saturables massifs présentent notamment l'inconvénient d'une concentration en ion absorbant limité, qui nécessite l'emploi d'une grande épaisseur de matériau.

Pour remédier aux problèmes posés par les absorbants saturables massifs, le document FR-A-2 712 743 décrit une cavité laser à milieu actif solide dans lequel l'absorbant saturable est réalisé sous la forme d'une couche mince monocristalline.

La forme de couche mince permet notamment de minimiser les pertes à l'intérieur de la cavité laser qui sont dues à la forme massive de l'absorbant saturable classique.

En outre, il est possible de déposer la couche mince sur des substrats de forme et de dimensions variées.

Enfin, la forme de couche mince permet également de réaliser un gain de place à l'intérieur de la cavité laser.

La couche mince est, dans ce document, réalisée de préférence par épitaxie en phase liquide. Une telle technique de dépôt permet notamment d'accéder à des concentrations en dopants plus élevées que les

procédés classiques de croissance de cristaux massifs, c'est-à-dire les procédés tels que Czochralski, Bridgman...

Elle permet également d'élaborer plus
5 facilement des couches monocristallines dopées par différents ions. Par ailleurs, l'épitaxie en phase liquide (EPL) est le seul procédé classique qui permette d'obtenir des couches monocristallines d'épaisseurs importantes supérieures, par exemple à
10 100 μm .

Dans ce document ainsi que dans le document EP-A-0 653 824, il est également décrit le dépôt par épitaxie en phase liquide de la couche mince d'absorbant saturable, directement sur le matériau
15 actif laser jouant le rôle de substrat.

Pour cela, il faut que le matériau actif soit de même structure que le matériau absorbant saturable et que l'épitaxie en phase liquide de ce matériau soit réalisable.

20 A ce jour, seul $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ (YAG) remplit ces conditions.

Ainsi un microlaser (ou laser puce) classique déclenché passivement est constitué généralement d'un matériau actif laser par exemple en
25 YAG : Nd qui est le milieu actif émetteur de lumière émettant à 1,06 μm , sur lequel est épitaxiée une couche par exemple de YAG : Cr^{4+} plus ou moins épaisse et plus ou moins concentrée en Cr^{4+} suivant les performances dérivées.

30 Le procédé de fabrication d'un tel microlaser est décrit dans le brevet EP-A-0 653 824 déjà mentionné.

Après épitaxie de YAG : Cr^{4+} sur le substrat de YAG : Nd, une étape de polissage permet d'obtenir une lame ayant le parallélisme, la planéité et l'épaisseur voulus.

5 Les miroirs d'entrée et de sortie de la cavité laser, formés par un empilement de couches diélectriques, sont ensuite déposés sur les faces de la lame.

10 La lame est enfin découpée en microlasers élémentaires. Plusieurs centaines de microlasers peuvent ainsi être fabriqués de façon collective dans une seule lame.

Il est à noter que, dans tous les cas, le cristal émetteur YAG : Nd est orienté suivant l'axe [111], qui est l'axe de croissance normale des grenats, 15 et qui permet d'obtenir un rendement laser maximum.

Le YAG: Cr^{4+} épitaxié a donc cette même orientation, le cristal émetteur en YAG : Nd jouant le rôle de substrat.

20 De ce fait et malgré tous les avantages qu'il présente, le procédé de fabrication classique de microlasers tel qu'il est décrit ci-dessus ne permet pas de contrôler la polarisation du faisceau des microlasers.

25 En effet, les microlasers fabriqués dans des cristaux orientés [111] ont une direction de polarisation qui dépend généralement des contraintes résiduelles engendrées par l'épitaxie. La direction de polarisation n'est pas constante sur toute la surface 30 du substrat ou lame dans lequel les microlasers ont découpés.

Il existe cependant des méthodes pour fixer la polarisation du microlaser en appliquant une

contrainte sur une des faces latérales du microlaser. Mais dans ce cas, il faut prévoir un montage permettant d'appliquer une contrainte sur chaque microlaser élémentaire, ce qui est incompatible avec un procédé de fabrication collective.

Par ailleurs, dans les dispositifs classiques, des cristaux massifs de YAG : Cr^{4+} sont utilisés comme absorbants saturables et sont placés dans la cavité laser le plus près possible du cristal émetteur. Dans ce cas leurs dimensions sont de l'ordre de quelques millimètres et les cristaux de YAG : Cr^{4+} sont généralement orientés suivant l'axe cristallographique [100]. En effet, le maximum de saturation est obtenu lorsque le faisceau incident est polarisé parallèlement à un axe cristallographique du cristal. Les cavités laser ainsi obtenues ne présentent jamais un faisceau laser dont la polarisation peut être définie à l'avance. Il n'y a donc pas de possibilités de prévoir quelle sera la polarisation du faisceau émis avant de le tester.

Or l'obtention d'un faisceau polarisé linéairement est très importante dans de nombreuses applications comme l'optique non linéaire en général et le doublage de fréquence en particulier.

Dans l'état actuel de la technique, il n'est pas possible de fabriquer collectivement des microlasers doublés en fréquence. Le cristal non linéaire qui assure la conversion de fréquence doit être tourné en fonction de la polarisation du faisceau de chaque microlaser, sans connaissance a priori de la direction de polarisation du faisceau.

L'inhomogénéité de la polarisation du faisceau sur le substrat ne permet pas d'assembler le

substrat avec une lame de matériau non linéaire et de le découper ensuite pour fabriquer collectivement des microlasers doublés en fréquence.

Il existe donc un besoin non encore satisfait pour une cavité laser présentant une direction de polarisation parfaitement contrôlée, connue, et constante sur l'ensemble du substrat en particulier de la lame, jouant le rôle de matériau actif laser.

Il existe en outre un besoin pour une cavité laser et pour un microlaser ayant une direction de polarisation connue, et constante, et qui puissent être obtenues par un procédé éprouvé de fabrication collective sans avoir recours à d'autres étapes, ou utiliser des montages complexes.

Le but de l'invention est, entre autres, de répondre à ces besoins, et de fournir une cavité laser et un laser tel qu'un microlaser qui ne présentent pas les inconvénients, défauts et limitations des cavités lasers et des lasers, en particulier, des microlasers de l'art antérieur, et qui résolvent les problèmes de l'art antérieur.

Ce but, et d'autres encore, sont atteints, conformément à l'invention, par une cavité laser à polarisation contrôlée comprenant un substrat en matériau actif laser $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG) dopé ou non, sur lequel est déposé directement par épitaxie en phase liquide ou par un procédé analogue, une couche monocristalline de matériau absorbant saturable en YAG dopé, dans laquelle ledit matériau actif laser est orienté [100], et ladite couche monocristalline de matériau absorbant saturable est déposée suivant la même orientation [100].

Selon l'invention ladite couche monocristalline de matériau absorbant saturable en YAG dopé est obtenue par épitaxie en phase liquide (EPL) ou par un procédé analogue c'est-à-dire par un procédé permettant d'obtenir une couche ayant les mêmes caractéristiques qu'une couche obtenue par EPL, un tel procédé peut être par exemple un procédé de dépôt en phase vapeur ou un procédé de dépôt par ablation laser.

On peut alors, en d'autres termes, parler d'une couche susceptible d'être obtenue par épitaxie en phase liquide.

De préférence toutefois la couche monocristalline de matériau absorbant saturable est obtenue par épitaxie en phase liquide.

La cavité laser selon l'invention dans laquelle le substrat en matériau actif laser est orienté [100] se différencie fondamentalement des cavités de l'art antérieur dans lesquelles les substrats en matériau actif laser YAG sont orientés suivant la direction [111].

En effet, dans le cas notamment de plaques microlasers fabriquées à partir de substrats orientés [111] il apparaît que la direction de polarisation n'est jamais constante sur ces plaques quel que soit le type de pompage.

Au contraire, sur les plaques comprenant un substrat en matériau actif laser YAG orienté [100], selon l'invention, le faisceau peut être polarisé selon deux directions perpendiculaires privilégiées. Sur une telle plaque, selon l'invention, la direction de polarisation du faisceau laser est constante quel que soit la nature de la source de pompage.

Ainsi, si le pompage est fait avec une source non-polarisée la direction de polarisation du faisceau laser émis est constante, tandis que si le pompage est fait avec une source polarisée, la direction de polarisation du faisceau laser émis est également constante et selon l'une des deux directions privilégiées.

Le choix de l'une de ces directions dépend de la direction de polarisation du faisceau de pompe.

10 Dans tous les cas, la cavité laser selon l'invention, du fait de son orientation spécifique [100] présente une direction de polarisation constante et connue à l'avance pour des conditions de pompage données.

15 Selon l'invention, le faisceau du laser tel qu'un microlaser est obtenu directement polarisé, sans qu'aucune autre opération ou montage ne soit nécessaire, du seul fait du choix de l'orientation spécifique [100].

20 De ce fait, les cavités lasers selon l'invention peuvent être facilement fabriquées par un procédé de fabrication collective connu et éprouvé.

Le substrat est selon l'invention un substrat en matériau actif laser $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG) dopé ou
25 non qui est orienté [100].

Le substrat et la couche monocristalline d'absorbant saturable, également orientée [100] sont donc de même structure cristallographique mais il est souvent nécessaire d'ajuster les paramètres de maille
30 du substrat et/ou de la couche monocristalline. Cet ajustement se fait généralement à l'aide des dopants adéquates décrits plus loin dans le cadre de la description détaillée de la couche monocristalline,

lesdits dopants étant éventuellement ajoutés dans le bain d'épitanie sous la forme d'oxyde(s).

Autrement dit, le substrat et la couche, qui comme on l'a déjà indiqué, sont de même structure
5 au point de vue cristallographique, ne se différencient que par leurs différents dopants qui affectent par exemple les propriétés cristallines et/ou optiques de la couche et/ou du substrat, de préférence de la couche.

10 Selon l'invention, le substrat est un matériau actif laser YAG c'est-à-dire qu'il est dopé ou non, par un ou plusieurs ion(s) lui conférant des propriétés de matériau actif laser et choisi(s) par exemple parmi les ions Nd, Cr, Er, Yb, Ho, Tm, et Ce.

15 Notons au passage que la plupart des ions utilisés pour conférer au YAG des propriétés de matériau actif laser peuvent être ainsi utilisées pour rendre le YAG amplificateur.

Ainsi le YAG peut être dopé avec des ions
20 actifs Nd (néodyme) ou Yb (Ytterbium) pour une émission autour de 1,06 μm , avec des ions actifs Er (Erbium) pour une émission autour de 1,5 μm , avec des ions actifs Ho (Holmium) ou Tm (Thullium) pour une émission à 2 μm , le YAG peut également être codopé par des ions
25 Er et Yb (Erbium-Ytterbium) pour une émission à 1,5 μm , par des ions Tm et Ho (Thullium et Holmium) pour une émission à 2 μm , ou par des ions Er, Yb, et Ce (Erbium, Ytterbium et Cérium) pour une émission à 1,5 μm .

De préférence, le YAG est dopé au néodyme,
30 ce matériau est le matériau laser solide le plus connu et le plus utilisé actuellement.

La proportion du ou des ions dopant(s) est généralement (en mole) de 0,1 à 10% pour chacun d'entre eux.

5 Selon une caractéristique fondamentale de l'invention, le substrat en matériau actif laser est spécifiquement orienté [100]. Pour obtenir une telle orientation on peut soit orienter un cristal tiré suivant la direction traditionnelle [111], soit tirer directement un cristal suivant l'orientation [100], ce
10 qui est possible moyennant quelques adaptations des conditions de croissance.

La dimension et la forme du substrat , comme cela est décrit plus loin, sont variables. L'un des avantages de la technique d'épitaxie en phase
15 liquide est précisément qu'elle permet de réaliser des couches d'excellente qualité, quelle que soit la forme, même complexe et la taille du substrat.

Le substrat peut être constitué soit d'un barreau laser classique, soit avantageusement selon
20 l'invention d'un substrat microlaser qui est constitué d'une lame monocristalline d'une épaisseur par exemple de 500 μm à 2 mm de préférence de 0,1 mm à 2 mm. De préférence cette lame est polie avec ses deux faces parallèles.

25 La couche monocristalline de matériau absorbant saturable en YAG, selon l'invention, présente une structure spécifique qui permet de garder la faisabilité d'un dispositif compact et d'une fabrication collective à bas coût.

30 Cette structure ne remet pas en cause les propriétés du matériau, mais au contraire permet de les améliorer par utilisation des phénomènes d'ondes guidées dans certains cas.

Les couches monocristallines de matériau absorbant saturable selon l'invention présentent, en outre, tous les avantages inhérents au procédé de croissance par épitaxie en phase liquide (EPL) par lequel elles sont obtenues ou susceptibles d'être obtenues. Ces avantages sont développés de manière plus approfondie dans le document de l'art antérieur cité ci-dessus.

En particulier, il est possible, par ce procédé d'EPL, d'obtenir, des dopages homogènes, par exemple en chrome, terres rares, en métaux de transition, ou en gallium.

Ce paramètre d'homogénéité est un paramètre essentiel lorsque l'on veut optimiser les performances optiques d'un dispositif.

Dans la technique d'épitaxie en phase liquide, selon l'invention, les couches sont réalisées à température constante dans la gamme définie plus loin et présentent, de ce fait, une bonne homogénéité de composition en volume.

Seuls l'interface et la surface de la couche peuvent être éventuellement perturbés, mais alors un léger polissage de la surface permet de s'affranchir de ce défaut.

De plus, l'épitaxie permet d'accéder à des concentrations en dopant beaucoup plus élevées que les procédés classiques de croissance de cristaux massifs, ce qui permet d'utiliser des couches de très faible épaisseur avec les avantages qui en découlent.

L'épitaxie en phase liquide offre, par ailleurs, la possibilité de réaliser des codopages par différents ions, en effet, il est souvent nécessaire d'utiliser plusieurs substitutions pour optimiser les

propriétés de la couche épitaxiée, telles que le paramètre de maille, l'indice de réfraction, l'absorption etc...

Par la technique d'épitaxie en phase
5 liquide, il est possible de préparer des couches de compositions complexes à plusieurs cations.

La technique d'épitaxie en phase liquide permet un contrôle aisé de l'épaisseur de la couche déposée, celle-ci a, généralement, une épaisseur de 1 à
10 500 μm , de préférence de 1 à 200 μm , de préférence encore de 20 à 150 μm , mieux de 50 à 100 μm .

On parlera de « couches minces » pour des épaisseurs généralement de 1 à 150 μm , de préférence de 1 à 100 μm .

15 la vitesse de croissance étant généralement de l'ordre de 1 $\mu\text{m}/\text{mn}$; on peut relativement rapidement, c'est-à-dire en l'espace de quelques heures, préparer des couches ayant une épaisseur de 100 μm .

20 Par couche monocristalline de matériau absorbant saturable en YAG dopé on entend un YAG ayant au moins une substitution par un ion lui conférant des propriétés d'absorbant saturable.

Ainsi le YAG peut-il être dopé par un ou
25 plusieurs ions dopants choisi(s) parmi les ions Chrome (Cr), Erbium (Er), Thullium (Tm) et Holmium (HO).

De préférence, ledit ion dopant est le chrome Cr^{4+} .

La proportion du ou des dopant(s) conférant
30 au YAG ses propriétés d'absorbants saturable est généralement (en mole) de quelques %, par exemple de 1 à 10 % pour chacun des dopants.

Par ailleurs le YAG est généralement tout d'abord substitué par des ions Mg^{2+} de sorte que la substitution avec les ions actifs tels que les ions Cr^{4+} peut s'opérer sans compensation de charge.

5 C'est-à-dire que dans ce cas le YAG contient en définitive dans la couche autant de moles de Mg^{2+} que de moles de dopant en particulier de Cr^{4+} .

De même que l'épaisseur, le taux de dopage et la nature du dopant de la couche d'absorbant saturable sont adaptés au laser que l'on veut
10 déclencher afin que la couche monocristalline d'absorbant saturable présente une absorption saturable convenable à la longueur d'onde d'émission du laser.

Par exemple, on choisira du Cr^{4+} pour un
15 laser émettant à $1,06 \mu m$, du Er^{3+} pour un laser émettant à $1,5 \mu m$ ou encore du Thullium (Tm) ou de l'Holmium (Ho) pour un laser émettant à $2 \mu m$.

De ce fait, à un ion actif laser du matériau actif laser correspondra préférentiellement un
20 ion actif de la couche d'absorbant saturable.

Les couples suivants ion actif laser - ion absorbant saturable conviennent bien : Nd-Cr, Er-Er, Tm-Ho, Yb-Cr.

Selon l'invention le couple Nd-Cr est
25 particulièrement préféré.

La couche monocristalline de matériau absorbant saturable orientée [100], ou le substrat, de préférence la couche, peuvent également comprendre (en outre) au moins un (autre) dopant ou substituant afin
30 d'en modifier l'une ou l'autre de leurs propriétés, par exemple structurales et/ou optiques, telles que l'absorption, l'indice de réfraction et/ou le paramètre de maille.

Ces dopants sont choisis par exemple parmi le gallium et les terres rares non actives, telles que le lutécium, le gadolinium, l'yttrium ; par terres rares non actives on entend généralement des terres
5 rares qui ne communiquent pas des propriétés telles que des propriétés d'émetteur laser, d'amplificateur ou d'AS au YAG.

On pourra ainsi en outre réaliser un codopage des couches avec du Gallium (Ga) et/ou une
10 terre rare non active telle que l'yttrium (Y), et/ou le lutécium (Lu) et/ou le gadolinium.

Un codopage supplémentaire préféré est un codopage Gallium-Lutécium, dans lequel le gallium sert à adapter l'indice, le gallium élargissant par ailleurs
15 la maille du réseau cristallin, cet élargissement est compensé par du Lutécium.

De manière classique la cavité laser comprend en outre un miroir d'entrée et un miroir de sortie. De préférence ces miroirs sont des miroirs
20 dichroïques.

Le miroir d'entrée est déposée directement sur le substrat en matériau actif laser et le miroir de sortie est déposé directement sur la couche monocristalline de matériau absorbant saturable.

25 La cavité laser selon l'invention peut prendre plusieurs formes chacune correspondant à la forme que peut prendre le substrat en matériau actif laser, on pourra de nouveau à ce propos se reporter au document FR-A-2 712 743.

30 Ainsi dans le substrat peut-il être un barreau laser ; mais, de préférence, selon l'invention le substrat est un substrat microlaser constitué d'une

lame monocristalline, de préférence une lame à faces parallèles polie sur ses deux faces.

L'invention concerne également un procédé de fabrication collective de cavités microlasers déclenchées à polarisation contrôlée.

Ce procédé est sensiblement identique au procédé classique connu de fabrication de microlasers mais il s'en différencie fondamentalement par l'orientation spécifique [100] du substrat en matériau actif laser et de la couche monocristalline de matériau absorbant saturable.

Ce procédé comprend généralement donc les étapes suivantes :

- on fournit un substrat en matériau actif laser $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG) dopé ou non, orienté [100] sous la forme d'une lame à faces parallèles polie sur ses deux faces;

- on dépose sur l'une des faces dudit matériau actif laser $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG), une couche monocristalline de matériau absorbant saturable en YAG dopé, par épitaxie en phase liquide ou par un procédé analogue ;

- on polit la couche monocristalline d'absorbant saturable ainsi déposée ;

- on dépose les miroirs d'entrée et de sortie sur les deux faces polies de la cavité ;

- on découpe l'ensemble substrat-couche monocristalline-miroirs ainsi obtenu.

On obtient ainsi un grand nombre de cavités microlasers (ou microlasers) déclenchées, tous ces microlasers présentent des caractéristiques de polarisation connues et identiques ce qui diminue de ce fait fortement leur coût.

L'invention concerne enfin un laser de préférence un microlaser déclenché à polarisation contrôlé comprenant une cavité telle que décrite ci-dessus de préférence une cavité microlaser ainsi que
5 des moyens de pompage de celle-ci.

De préférence ces moyens de pompage consistent en au moins une lampe ou une diode qui pompe la cavité selon une direction transversale ou longitudinale.

10 Le procédé selon l'invention du fait, de nouveau de l'orientation spécifique $[1,0,0]$ du substrat et de la couche monocristalline, permet de fabriquer collectivement des microlasers ayant une direction de polarisation connue, ce qui n'avait jamais été réalisé
15 dans l'art antérieur. En effet, le faisceau du microlaser est obtenu directement polarisé sans aucune autre opération ou montage ce qui est compatible avec un procédé de fabrication collective.

Par ailleurs, les performances du
20 microlaser obtenues ne sont absolument pas dégradées, par rapport aux microlasers préparés avec des substrats et couches d'AS classiques orientés $[111]$. Ce maintien des performances malgré le choix inattendu d'une orientation différente constitue l'un des effets et
25 avantages inattendus de l'invention.

Les performances n'étant pas dégradées permettent de ce fait l'utilisation du microlaser selon l'invention dans de nombreuses applications telles que le doublage de fréquence. Il n'est pas nécessaire de
30 tester individuellement chaque microlaser ou d'utiliser un moyen externe pour déterminer la direction de polarisation puisque tous les microlasers ont des caractéristiques de polarisation connues et identiques.

Outre, la réalisation en particulier de microlasers verts impulsionnels de façon collective, l'invention trouve son application de manière générale dans tous les domaines de l'optique non linéaire et dans tous les cas où un faisceau impulsional polarisé linéairement est nécessaire, comme par exemple le 5 doublage de fréquence, la conversion de fréquence tels que le triplage, le quadruplage etc..., et l'oscillation paramétrique optique (OPO).

10 Les caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui va suivre donnée à titre purement illustratif et non limitatif.

Ainsi, de manière plus précise, le procédé 15 de l'invention comprend tout d'abord, généralement, une première étape de choix et de préparation du substrat.

Comme mentionné plus haut, le substrat peut être tout substrat sur lequel peut être déposé une couche par exemple une couche mince de YAG, par la 20 technique d'épitaxie en phase liquide, à la condition essentielle dans l'invention, que le matériau dudit substrat soit orienté [100].

Ces substrats ont déjà été pour la plupart décrits ci-dessus.

25 Le type de laser à réaliser détermine l'ion ou les ions dopant(s) de la couche de YAG déposé, ainsi que le type de YAG utilisé pour le substrat.

Le mode de fonctionnement de ce laser détermine si le substrat doit être constitué d'un 30 matériau actif laser ou non, ainsi que sa forme et ses dimensions.

La dimension et la forme du substrat sont variables, l'un des avantages de la technique

d'épitéaxie en phase liquide est précisément qu'elle permet de réaliser des couches d'excellente qualité, quelle que soit la forme, même complexe, et la taille du substrat.

5 Le substrat peut, par exemple, être préparé à partir d'un lingot de YAG dopé ou non, d'un diamètre, par exemple, de 1'' à 2'' (inches), c'est-à-dire environ 25 à 50 mm, orienté [100].

10 Pour obtenir une telle orientation au substrat, on peut, soit orienter un cristal tiré suivant la direction traditionnelle [111], soit tirer directement un cristal suivant l'orientation [100] ce qui est possible moyennant quelques adaptations des conditions de croissance : diminution de la vitesse de
15 tirage, augmentation du temps de refroidissement.

 Quel que soit le mode de fabrication des cristaux orientés [100] ils peuvent de toute façon être facilement obtenus sur le marché.

20 On découpe à partir de ce lingot des substrats, par exemple en forme de lames à faces parallèles à l'aide d'un instrument de coupe adéquate, par exemple à l'aide d'une scie à lame diamantée. Ces substrats en forme de lame peuvent avoir une épaisseur variable par exemple de 500 μm à 2 mm.

25 On procède ensuite au rodage et au polissage d'au moins une des faces du substrat. Le rodage a pour rôle :

- d'une part, d'enlever la couche d'écrouissage superficielle due à la découpe ;
- 30 - d'autre part, éventuellement, de ramener l'épaisseur des lames à l'épaisseur voulue, par exemple dans le cas d'une application laser, cette épaisseur

est légèrement supérieure à la spécification du microlaser et est généralement de 100 à 1000 μm .

En effet, l'épaisseur du milieu actif est un paramètre qui conditionne certaines caractéristiques du microlaser, telles que la largeur du spectre et le
5 nombre de modes longitudinaux, notamment.

Les substrats, par exemple les lames rodées et, éventuellement, rapprochées de l'épaisseur voulue, sont ensuite polis avec une qualité optique.

10 Le polissage concerne au moins une des faces du substrat, mais pour certains types de fonctionnement, par exemple pour un laser guide d'ondes, le substrat peut présenter deux faces parallèles ayant cette qualité de poli.

15 On parle ainsi de substrat à une face polie, ou à deux faces polies.

Le polissage est réalisé par un procédé mécano-chimique afin que la ou les faces polie(s) soi(ent) exempte(s) de tout défaut (inclusion,
20 dislocation, contrainte, rayure, etc.) qui se propagerait dans l'épaisseur de la couche lors de l'épitaxie. Cette qualité de polissage est contrôlée par une attaque chimique appropriée. Le procédé à mettre en oeuvre est sensiblement identique à celui mis
25 au point pour les substrats utilisés dans les techniques classiques d'épitaxie.

Suite à la première étape, de choix et de préparation du substrat, on procède ensuite dans une deuxième étape à la préparation du bain d'épitaxie qui
30 est une solution sursaturée formée d'un solvant et d'un soluté.

Selon l'invention, le bain d'épitaxie est préparé, tout d'abord, en pesant soigneusement un

mélange des oxydes PbO - B_2O_3 - le mélange de ces deux oxydes formant le solvant - Y_2O_3 et Al_2O_3 qui forment le soluté.

Le ou les différent(s) dopant(s) est(sont) également, éventuellement, ajouté(s) sous forme d'oxyde(s), par exemple CrO_2 et MgO , il est également parfois nécessaire, pour réaliser la compensation de charges éventuelle, d'ajouter un ou plusieurs autres oxydes tels que les oxydes des éléments cités plus haut.

La concentration en moles % des différents oxydes dans le bain d'épitaxie pour la préparation de YAG non dopé est en mole %, par exemple, de 0,5 à 0,7 mole % de Y_2O_3 , de 1,5 à 2,5 mole % de Al_2O_3 , de 80 à 90 mole % de PbO , et de 5 à 10 mole % de B_2O_3 .

Le ou les oxydes du ou des dopant(s) lorsqu'il(s) est(sont) présent(s) est(sont) dans les proportions indiquées ci-dessus pour chacun d'entre eux c'est-à-dire par exemple 0,5 à 2,0 mole % de CrO_2 et 0,5 à 2,0 mole % de MgO .

Un mélange typique est, à titre d'exemple, constitué de 14 g de Y_2O_3 , 15 g de Al_2O_3 , 6 g de MgO , 23 g de CrO_2 , 1700 g de PbO et 45 g de B_2O_3 .

Le mélange soluté, solvant est ensuite fondu dans un dispositif adéquat, par exemple dans un creuset en platine à une température, par exemple, de 900 à 1100°C, par exemple d'environ 1000°C pour former le bain d'épitaxie proprement dit. Le dispositif, tel qu'un creuset, est ensuite placé dans un dispositif classique permettant de réaliser une croissance cristalline par épitaxie en phase liquide.

Ce dispositif est, par exemple, un four d'épitaxie qui est, en particulier, un four à deux zones de chauffe, à gradient de température contrôlé.

De préférence, le substrat est animé d'un
5 mouvement de rotation ou de translation uniforme, ou alterné permettant un dépôt d'une épaisseur homogène.

De même, le bain d'épitaxie peut être agité mécaniquement à l'aide d'un dispositif adéquat, tel qu'un agitateur en platine.

10 Une broche supportant l'agitateur, ou l'ensemble porte substrat-substrat permet de communiquer les mouvements voulus à l'un ou l'autre.

La troisième étape du procédé est l'étape d'épitaxie proprement dite.

15 Selon l'invention, l'opération d'épitaxie en phase liquide est réalisée à une température constante dans la plage de 1000°C à 1100°C, ce qui permet d'obtenir une concentration en dopant homogène dans l'épaisseur de la couche de YAG.

20 On commence, par exemple, à agiter mécaniquement le mélange liquide à une température légèrement supérieure à la température de croissance épitaxiale, par exemple, à environ 1150°C à l'aide du dispositif d'agitation déjà décrit plus haut, tel qu'un
25 agitateur en platine. On abaisse ensuite la température du four jusqu'à la température de trempe qui est, de préférence, encore de 1000 à 1100°C.

Le substrat, par exemple positionné horizontalement est ensuite mis en contact avec le bain
30 d'épitaxie, les substrats à une face polie sont trempés en surface du bain alors que les substrats à deux faces polies sont immergés dans ce bain.

La durée de la mise en contact dépend de

l'épaisseur désirée, cette épaisseur pouvant varier dans les plages déjà citées plus haut, c'est-à-dire de 1 à 500 μm , par exemple 100 μm . Les vitesses de croissance sont généralement de l'ordre de 0,5 (???) à 1 $\mu\text{m}/\text{mn}$ (???)

Selon l'invention et afin de tenir compte de la différence de comportement entre les substrats orientés [111] de l'art antérieur et les substrats orientés [100] mis en oeuvre dans l'invention, une adaptation des conditions de croissance est nécessaire car l'orientation [100] entraîne d'une part une augmentation de la vitesse de croissance et d'autre part une fragilité accrue des cristaux, la durée de la trempe ou durée de mise en contact est légèrement diminuée dans le procédé de l'invention et sera donc généralement diminué d'environ 1/4 de temps par rapport aux substrats orientés [111]

Par ailleurs et de nouveau pour prendre en considération la différence de comportement entre les substrats orientés [111] et [100] les phases de refroidissement sont particulièrement contrôlées pour diminuer au maximum les chocs thermiques : remontée lente du substrat hors du four à une vitesse de 10 mm par minute au lieu de 50 mm par minute.

A la sortie du bain d'épitaxie, le substrat et la (pour un substrat à une face) ou les couche(s) épitaxiée(s) (pour un substrat à deux faces, avec une couche épitaxiée sur chaque face) subissent une opération destinée à éliminer le solvant. Par exemple, le substrat revêtu est soumis à un mouvement de rotation accélérée pour éjecter les restes de solvant.

Un nettoyage chimique, au moyen par exemple d'un acide tel que HNO_3 , termine l'étape d'épitaxie.

Les étapes suivantes sont des étapes classiques analogues à celles mises en oeuvre pour la réalisation des microlasers orientés [1,1,1].

On effectue un polissage de la couche
5 d'absorbant saturable afin notamment d'ajuster ses propriétés d'absorption. Ce polissage est généralement réalisé par attaque chimique par exemple dans de l'acide phosphorique ou par polissage mécanochimique.

On dépose ensuite directement les miroirs
10 d'entrée et de sortie de la cavité laser et l'on découpe l'ensemble formé par le substrat en forme de lame, la couche monocristalline de matériau absorbant saturable, et les miroirs, en un grand nombre de cavités microlasers sous la forme par exemple de
15 parallélépipèdes généralement de 1mm x 1 mm donc chacun constitue une cavité microlaser déclenché, à polarisation parfaitement contrôlée.

Il a été constaté que les performances des microlasers obtenus telles que l'énergie de la
20 pulsation laser, sa durée, et sa fréquence de répétition, ne sont pas dégradées.

REVENDICATIONS

1. Cavit  laser   polarisation contr l e
comprenant un substrat en mat riau actif laser $Y_3Al_5O_{12}$
5 (YAG) dop  ou non, sur lequel est d pos  directement
par  pitaxie en phase liquide ou par un proc d 
analogue, une couche monocristalline de mat riau
absorbant saturable en YAG dop , dans laquelle ledit
mat riau actif laser est orient  [100], et ladite
10 couche monocristalline de mat riau absorbant saturable
est d pos e suivant la m me orientation [100].

2. Cavit  laser selon la revendication 1
dans laquelle ladite couche monocristalline de mat riau
absorbant saturable dop  est obtenue par  pitaxie en
15 phase liquide (EPL).

3. Cavit  selon l'une quelconque des
revendications 1 et 2 dans laquelle le substrat est un
mat riau actif laser YAG dop  par un ou plusieurs
ion(s) dopant(s) lui conf rant des propri t s de
20 mat riau actif laser choisis parmi les ions Nd, Cr, Er,
Yb, Ho, Tm, et Ce.

4. Cavit  selon la revendication 3 dans
laquelle ledit ion dopant est le N odyme (Nd).

5. Cavit  selon l'une quelconque des
25 revendications 3   4 dans laquelle la proportion du ou
des ion(s) dopant(s) est de 0,1   10 mole % pour chacun
d'entre eux.

6. Cavit  laser selon l'une quelconque des
revendications 1   5 dans laquelle la couche
30 monocristalline de mat riau absorbant saturable est en
YAG dop  par un ou plusieurs ion(s) dopant(s) choisi(s)
parmi les ions Chrome (Cr), Erbium (Er), Thullium (Tm)
et Holmium (Ho).

7. Cavit  laser selon la revendication 6
35 dans laquelle ledit ion dopant est le chrome.

8. Cavité selon l'une quelconque des revendications 6 et 7 dans laquelle la proportion du ou des ion(s) dopant(s) est de 1 à 10 mole % pour chacun d'entre eux.
- 5 9. Cavité selon l'une quelconque des revendications 1 à 8 dans laquelle la couche et/ou le substrat sont (en outre) dopé(s) par au moins un (autre) dopant ou substituant permettant de modifier leurs propriétés structurales et/ou optiques.
- 10 10. Cavité selon la revendication 9 dans laquelle ledit (autre) dopant est choisi parmi le gallium et les terres rares non actives.
- 15 11. Cavité selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 dans laquelle la couche monocristalline de matériau absorbant saturable a une épaisseur de 1 à 500 μm .
- 20 12. Cavité selon la revendication 10 dans laquelle ladite couche monocristalline de matériau absorbant saturable est une couche mince d'une épaisseur de 1 à 150 μm .
- 25 13. Cavité laser selon l'une quelconque des revendications 1 à 12 qui comprend en outre un miroir d'entrée et un miroir de sortie, ledit miroir d'entrée étant déposé directement sur le substrat en matériau actif laser.
- 30 14. Cavité laser selon la revendication 12 dans laquelle le miroir de sortie est déposé directement sur la couche monocristalline de matériau absorbant saturable.
15. Procédé de fabrication collective de cavités microlasers déclenchées à polarisation contrôlée comprenant les étapes suivantes :
- on fournit un substrat en matériau actif laser $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ (YAG) dopé ou non, orienté [100] sous la

forme d'une lame à faces parallèles polie sur ses deux faces;

5 - on dépose sur l'une des faces dudit matériau actif laser $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG), une couche monocristalline de matériau absorbant saturable en YAG dopé, par épitaxie en phase liquide ou par un procédé analogue ;

10 - on polit la couche monocristalline d'absorbant saturable ainsi déposée ;
 - on dépose les miroirs d'entrée et de sortie sur les deux faces polies de la cavité ;

 - on découpe l'ensemble substrat-couche monocristalline-miroirs ainsi obtenu.

15 16. Laser déclenché à polarisation contrôlée comprenant une cavité selon l'une quelconque des revendications 1 à 14 ainsi que des moyens de pompage de cette cavité.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 98/02848

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 H01S3/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 H01S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 5 394 413 A (ZAYHOWSKI JOHN J) 28 February 1995 see abstract see column 5, line 22 - line 33 ---	1-16
Y	LIU H ET AL: "SINGLE-FREQUENCY Q-SWITCHED CR-ND: YAG LASER OPERATING AT 946-NM WAVELENGTH" IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, vol. 3, no. 1, February 1997, pages 26-28, XP000694385 see page 27, left-hand column, line 15 - line 32 --- -/--	1-8, 15

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 April 1999

Date of mailing of the international search report

19/04/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Galanti, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 98/02848

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 653 824 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 17 May 1995 cited in the application see column 14, line 36 - column 16, line 6 ---	9-16
A	US 5 414 724 A (GUI YOUXI ET AL) 9 May 1995 see column 5, line 33 - line 44 -----	1,3-7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 98/02848

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5394413	A	28-02-1995	DE 69504475 D	08-10-1998
			EP 0744089 A	27-11-1996
			ES 2120733 T	01-11-1998
			JP 9508755 T	02-09-1997
			WO 9522186 A	17-08-1995
			US 5483546 A	09-01-1996
EP 0653824	A	17-05-1995	FR 2712742 A	24-05-1995
			JP 7183608 A	21-07-1995
			US 5495494 A	27-02-1996
US 5414724	A	09-05-1995	NONE	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Der...nde internationale No

PCT/FR 98/02848

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 6 H01S3/06

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 H01S

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	US 5 394 413 A (ZAYHOWSKI JOHN J) 28 février 1995 voir abrégé voir colonne 5, ligne 22 - ligne 33	1-16
Y	LIU H ET AL: "SINGLE-FREQUENCY Q-SWITCHED CR-ND: YAG LASER OPERATING AT 946-NM WAVELENGTH" IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, vol. 3, no. 1, février 1997, pages 26-28, XP000694385 voir page 27, colonne de gauche, ligne 15 - ligne 32	1-8, 15

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

12 avril 1999

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

19/04/1999

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Galanti, M

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

De. ...nde internationale No

PCT/FR 98/02848

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	EP 0 653 824 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 17 mai 1995 cité dans la demande voir colonne 14, ligne 36 - colonne 16, ligne 6 ---	9-16
A	US 5 414 724 A (GUI YOXI ET AL) 9 mai 1995 voir colonne 5, ligne 33 - ligne 44 -----	1,3-7

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem. internationale No

PCT/FR 98/02848

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5394413 A	28-02-1995	DE 69504475 D EP 0744089 A ES 2120733 T JP 9508755 T WO 9522186 A US 5483546 A	08-10-1998 27-11-1996 01-11-1998 02-09-1997 17-08-1995 09-01-1996
EP 0653824 A	17-05-1995	FR 2712742 A JP 7183608 A US 5495494 A	24-05-1995 21-07-1995 27-02-1996
US 5414724 A	09-05-1995	AUCUN	

THIS PAGE BLANK (USPTO)